

11; 12

© 1991

ТОНКИЕ ПЛЕНКИ ЖЕЛЕЗА НА Si (111) И СТРУКТУРА $\sqrt{3} \times \sqrt{3}-R30^\circ$

Ю.Л. Гаврилюк, Л.Ю. Качанова,
В.Г. Лифшиц

Введение

Исследуя микроскопическое поведение тонких пленок железа на кремнии, *Шаго* и др. [1, 2] показали полученную с помощью ДМЭ двумерную фазовую диаграмму системы. Они сообщают, что для пленок толщиной более 0.5 монослоя (ML) ДМЭ картина 1×1 изменяется в суперструктуру 2×2 при отжиге выше $400^\circ C$. Другие типы суперструктур на фазовой диаграмме отсутствуют.

Наши эксперименты показывают, что граница раздела системы Fe/Si (111) может реконструироваться также в структуру $\sqrt{3} \times \sqrt{3}-R30^\circ$.

Эксперименты проводились при базовом давлении $\sim 2 \cdot 10^{-10}$ Тор на установке *LAS-600* фирмы *RIBER*, оснащенной системой ДМЭ, ХПЭЭ и Оже-спектрометром с цилиндрическим анализатором. Монокристаллический кремний α -типа сопротивлением $5\Omega \cdot \text{см}^{-1}$ перед установкой в вакуумную камеру тщательно очищался в органических растворителях. Окончательная очистка производилась *in situ* отжигом в сверхвысоком вакууме при $1250^\circ C$ прямым пропусканием тока через образец. В результате наблюдалась четкая картина ДМЭ 7×7 и количество примесных атомов было ниже чувствительности Оже-спектрометра. Напыление железных пленок производилось со скоростью ~ 1 ML/мин из вольфрамовой корзинки при комнатной температуре (*R T*) подложки. Температура об разца определялась с помощью измерения проводимости. Поверхностная концентрация атомов Fe определялась из соотношения интенсивностей Оже-пиков Fe -MVV (48 эВ) и Si -LVV (92 эВ) с учетом коэффициентов элементной чувствительности [3, 4].

Результаты и обсуждение

Существует различие в значении поверхностной концентрации C_{Fe} до и после отжига. На рис. 1 приведены эти значения для пленок, полученных при различном времени напыления Fe . Здесь же указаны области покрытий, при которых после отжига наблюдаются различные суперструктуры. Поведение пленок Fe до отжига совпадает с данными [1]. При малых покрытиях ($C_{Fe} < 0.15$) наблюдается постепенно ослабевающая картина ДМЭ 7×7 и при больших покрытиях ($C_{Fe} > 0.15$) картина 1×1 , которая сопровождается повышенным фоном. Кроме того, при $0.15 < C_{Fe} < 0.30$ рефлексы имеют естественную ширину, а при $C_{Fe} > 0.30$ сильно

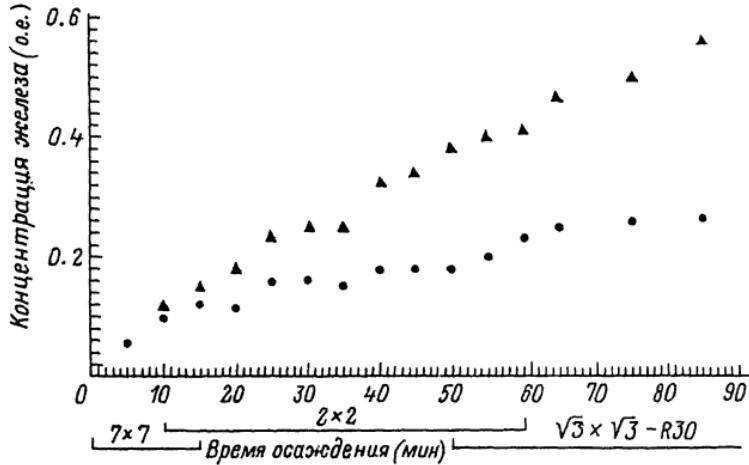
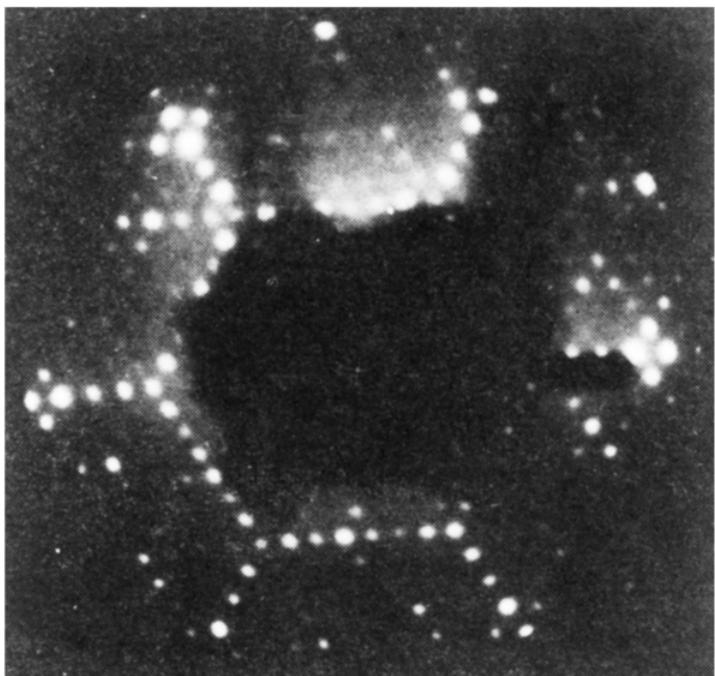


Рис. 1. Изменение поверхностной концентрации Fe на Si (111) при отжиге $450^{\circ}C$, 1 мин для различного времени напыления Fe .

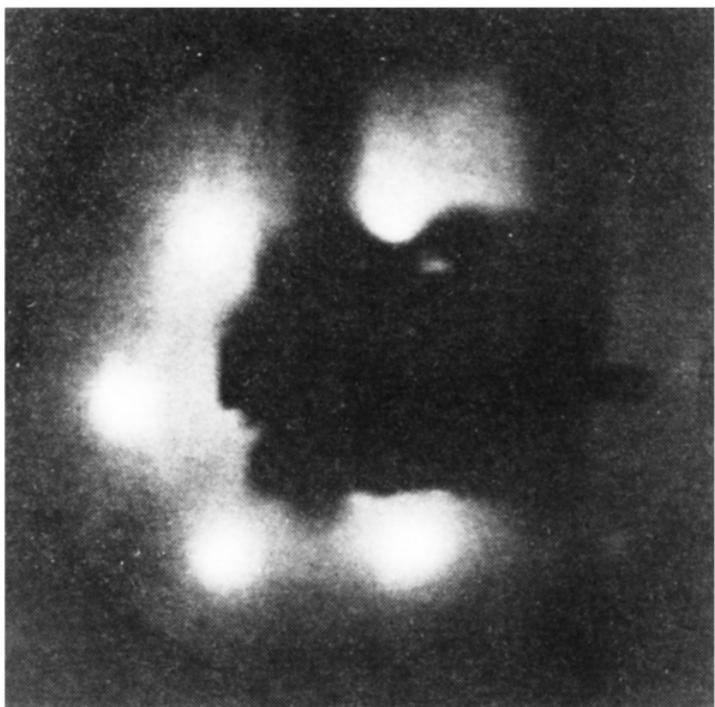
размыты. Структура 1×1 сохраняется и для толстых пленок (например, при толщине ~ 600 Å), т.е. пленка железа псевдоморфна и растет так, что атомы железа занимают те же места, что и атомы кремния. В результате получается эпитаксиальная пленка Fe (111). Уширенные рефлексы 1×1 показывают, что эта пленка при толщине больше одного монослоя состоит из отдельных блоков, одинаково ориентированных в азимутальной плоскости и имеющих размеры, соизмеримые с длиной когерентности электронов первичного пучка ДМЭ. Блочность возникает вследствие напряжений в пленке железа в плоскости, параллельной поверхности. Постоянная двумерной решетки триангулярной ОЦК структуры Fe (111) на 5 % больше, чем у Si (111) поверхности. Если пленка Fe толще 1 монослоя растет псевдоморфно, то решетка в направлении, параллельном поверхности ската, а в перпендикулярном растянута.

Поведение системы $Fe-Si$ после отжига при $T > 400^{\circ}C$ зависит от количества предварительно напыленного железа. Если $\theta \leq 1$ ML ($C_{Fe} \leq 0.33$), происходит перестройка структуры 1×1 в 2×2 . При этом определенная часть с помощью ЭОС поверхностная концентрация уменьшается до значения $C_{Fe} \approx 0.19$, что вызвано перемещением атомов железа во второй слой. Это подтверждается результатами ФЭС с угловым разрешением, которые показывают смену мест для адсорбированных атомов Fe [2].

Если до отжига $\theta > 2$ ML, после отжига при $400^{\circ}C < T < 530^{\circ}C$ ДМЭ картина отсутствует. Если же температура выше $530^{\circ}C$, наблюдается ДМЭ картина 1×1 . ХПЭС спектры, полученные для данной системы, подобны спектрам соединения $FeSi_2$ независимо, есть ли ДМЭ картина или отсутствует. Очевидно отжиг при $T > 530^{\circ}C$ приводит к упорядочению структуры дисилицида. Поверхностная концентрация после отжига во всех случаях составля-

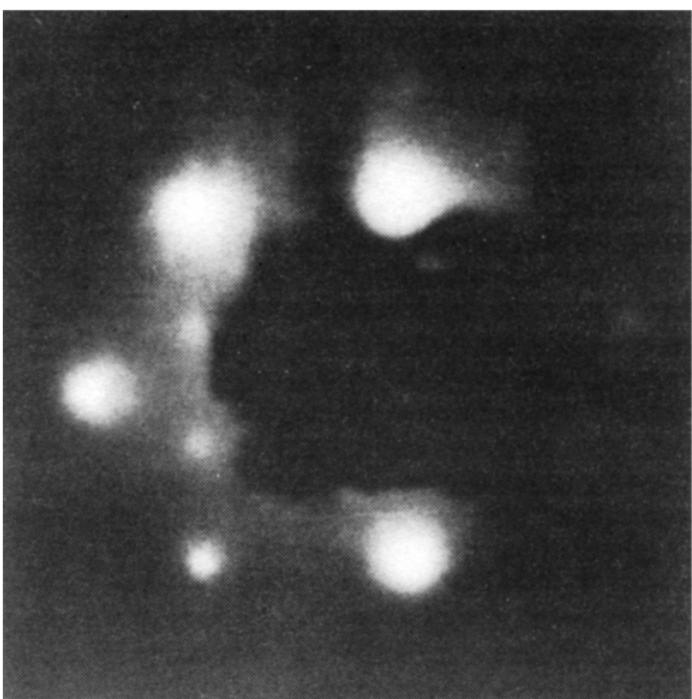
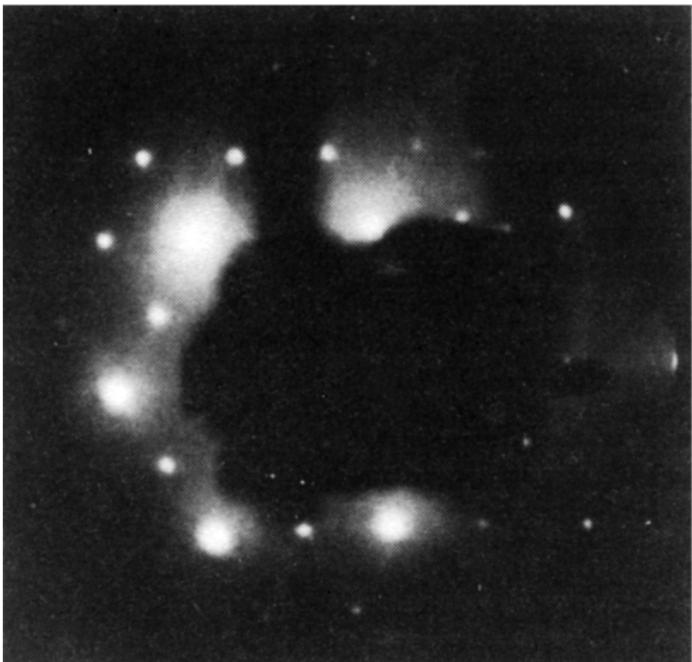


a



б

Рис. 2. ДМЭ картины: а - Si (111) 7x7, б - Si (111) 1x1, в - Si (111) 2x2- Fe , г - $\sqrt{3} \times \sqrt{3} - 30^\circ$. $E_p = 55$ эВ.



ет ~ 0.33 , в том числе и для больших предварительных покрытий (20–30 ML).

Если толщина пленки при RT больше 1 ML, но меньше 2 ML, после отжига возникает структура $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ – 30° (рис. 2). Оже-анализ показывает, что $C_{Fe} \approx 0.25$. Рефлексы ДМЭ картины размыты. Спектры ХПЭЭ полученной структуры аналогичны спектрам объемного силицида $FeSi$ и отличаются от спектров дисилицида и описанной выше структуры $Si(111) 2 \times 2 - Fe$. По-видимому, отжиг приводит к упорядоченному перемешиванию атомов железа и кремния в приповерхностном слое. Регистрируемая с помощью ЭОС поверхностная концентрация уменьшается. Несоизмеримая с решеткой кремния структура приводит к латеральным напряжениям в пленке и, как следствие, возникновению доменов. Поскольку размеры доменов малы, рефлексы ДМЭ картины размыты.

Выводы

Анализ тонких пленок железа на $Si(111)$ поверхности с помощью Оже, ДМЭ и ХПЭЭ-спектроскопии показывает, что при отжиге выше $400^\circ C$ образуются три различные структуры. Если $\Theta < 1$ ML, формируется поверхностная фаза $Si(111) 2 \times 2 - Fe$. Если 1 ML $< \Theta < 2$ ML образуется двумерный силицид $FeSi$ со структурой $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ – 30° . Для пленок более толстых, чем 2 ML, растет объемный дисилицид $FeSi_2$ со структурой 1×1 .

Список литературы

- [1] Urano T. and Kanai T. // Appl. Surf. Sci. 1988. V. 33/34. P. 68.
- [2] Urano T., Ogawa T., Kanai T. and Fujimoto F. // J. Vac. Sci. Technol. 1987. V. A5. P. 2046.
- [3] Palmberg P.W. // J. Vac. Sci. Technol. 1976. V. 13. P. 214.
- [4] Lifshits V.G., Akilov V.B., Churusov B.K., Gavriljuk Yu.L. // Surf. Sci. 1989. V. 222. P. 21.

Поступило в Редакцию
13 июня 1991 г.